BEST AVAILABLE COPY

Remarks:

Reconsideration of the application, as amended herein, is respectfully requested.

Claims 5, 7 and 8 are presently pending in the application.

Claim 5 has been amended. Claims 1 - 4 and 6 were previously canceled.

On pages 2 - 4 of the Office Action, the Examiner has requested that Applicants provide documentary evidence that a Demand was filed in the PCT case, establishing co-pendency of the present application with the PCT application. More particularly, pages 3 - 4 of the Office Action states, in part:

Noting that the 20-month period from the priority data (7/17/98) expired on 3/17/00, i.e., expired before 4/1/02, in order to extend the international phase to 30 months a demand should have been filed electing the Unites [sic] States prior to expiration of 19 months from said priority date of 7/17/98, i.e., prior to expiration date 2/17/00. Examiner sees no evidence of said demand having been filed and accordingly requires such evidence to be provided in order for co-pendency of the application with the international application to be verified. Short of this evidence examiner cannot recognize the continuing data nor the priority, and, depending on publication date, may actually qualify as prior art under 35 U.S.C. § 102(b). [emphasis added by Applicants]

Applicants are providing herewith, a copy of the bibliographic data for the PCT application from which the instant application claims priority, as printed from the WIPO website.

Page 4 of 10

The third line of the provided bibliographic data sheet for the PCT application shows that a Chapter 2 Demand was filed in connection with the PCT application on February 8, 2000 (i.e., "08.02.2000", under the European practice of writing the date). This bibliographic information can additionally be viewed on the WIPO website, at the following hyper-link:

www.wipo.int/pctdb/en/fetch.jsp?DISP=25&IDB=0&SORT=1172290
KEY&LANG=ENG&LANGUAGE=ENG&SERVER_TYPE=19&FORM=SEP-0%2FHITNUM%2CB-ENG%2CDP%2CMC%2CPA%2CABSUMENG&IA=DE1999002082&TOTAL=1&C=0&SEARCH_IA=DE1999002082&START=1&QUERY=PCT%2FDE99%2F02082&DBSELECT=PCT&TYPE_FIELD=256&RESULT=1&IDOC=94181&DISPLAY=STATUS

Additionally, Applicants are further including herewith, a copy of the International Preliminary Examination Report (IPER) issued in connection with the PCT application from which the present Application claims priority. An IPER is only issued in a PCT application if a Chapter II Demand has been made. The front page of the IPER additionally lists the date of the Demand ("Datum der einreichung des Antrags") as being February 8, 2000.

From the foregoing, it can be seen that a Chapter II Demand was made in connection with the international application from which the present application claims priority, on February 8, 2000, which is prior to February 17, 2000, and thus, the

present application was co-pending with the international application.

Additionally on page 4 of the Office Action, claims "1", 7 and 8 were rejected under 35 U.S.C. § 103(a) as allegedly being obvious over U. S. Patent No. 5,610,415 to Schulze ("SCHULZE") in view of Rosling et al., "A Study of Design Influence on Anode-Shorted GTO Thyristor Turn-On and Turn-Off", IEEE Transactions on Power Electronics, Vol. 9, No. 5, September 1994, pages 514 - 521 ("ROSLING"). Evidence on pages 5 - 6 of the Office Action supports that claims 5, 7 and 8 were cancelled under 35 U.S.C. § 103(a) over SCHULZE and ROSLING, and Applicants interpret the Office Action to so read.

Applicants respectfully traverse the rejections of claims 5, 7 and 8 over SCHULZE and ROSLING.

More particularly, in order to even more clearly define the invention of the instant application, Applicants' have amended claim 5 herein to recite, among other limitations:

a stop zone in front of said emitter region, said stop zone having foreign atoms with at least one energy level within the band gap of the semiconductor and at least 200 meV away from both a conduction band and a valence band of the semiconductor, such that, depending on whether the power semiconductor element is performing a conducting operation or a blocking operation, said stop zone is only partially electrically active in the on-state and said stop zone

is fully electrically active in the off-state for carriers emitted by the emitter region, said stop zone and said emitter region having mutually opposite conductivities. [emphasis added by Applicants]

As such, the amount to which the stop zone is electrically active (i.e., partially electrically active or fully electrically active) depends, in Applicants' claimed invention, on whether the power semiconductor element is performing a blocking operation or a conducting operation.

The amendment to claim 5 is supported by the specification of the instant application, for example, on page 3 of the instant application, lines 13 - 22, which state:

The invention is based on the principle that the stop zone needs to be "active" only in the off state of the circuit element, but not during its conducting operation. In other words, the number of effective doping atoms generated by the disruption in the stop zone should change dependent on the type of operation (blocking operation or conducting operation) of the circuit element. This is achieved in that energy levels are created by the doping atoms which, within the band gap of the semiconductor material, lie far away from the energy levels of the conductance band and the valence band. [emphasis added by Applicants]

The prior art references cited in the Office Action fail to teach or suggest, among other limitations of Applicants' claims, the amount to which a stop zone is electrically active being dependent on whether the power semiconductor element is performing a blocking operation or a conducting operation, as is currently required by Applicants' claims.

More particularly, col. 1 of the **SCHULZE** reference, lines 29 - 32, state:

This object is achieved in that at least the second emitter zone is doped with additional substances that act as dopants of the first conductivity type above the operating temperature of the semiconductor component. [emphasis added by Applicants]

In contrast to this disclosure in SCHULZE, the present invention requires, among other things, that the number of effective doping atoms in the stop zone (second emitter zone) be dependent on the type of operation (i.e., blocking operation or conducting operation) of the power semiconductor element.

The ROSLING reference, cited in the Office Action in combination with SCHULZE for allegedly disclosing the use of a silicon semiconductor layer, does not cure the above-discussed deficiencies of the SCHULZE reference.

As such, neither SCHULZE, nor ROSLING, teach or suggest, among other limitations of Applicants' claims, that, depending on whether the power semiconductor element is performing a conducting operation or a blocking operation, the stop zone is only partially electrically active in the on-state and is fully electrically active in the off-state. Thus, Applicants' present claims are believed to be patentable over the SCHULZE

and ROSLING references, whether taken alone, or in combination.

It is accordingly believed that none of the references, whether taken alone or in any combination, teach or suggest the features of claim 5. Claim 5 is, therefore, believed to be patentable over the art. The dependent claims 7 and 8 are believed to be patentable as well, because they both are dependent on claim 5.

In view of the foregoing, reconsideration and allowance of claims 5, 7 and 8 are solicited.

In the event the Examiner should still find any of the claims to be unpatentable, counsel would appreciate receiving a telephone call so that, if possible, patentable language can be worked out

If an extension of time for this paper is required, petition for extension is herewith made.

Please charge any fees that might be due with respect to Sections 1.16 and 1.17 to the Deposit Account of Lerner Greenberg Stemer LLP, No. 12-1099.

Respectfully submitted,

For Applicants

February 15, 2007

Lerner Greenberg Stemer LLP Post Office Box 2480 Hollywood, FL 33022-2480

Tel: (954) 925-1100 Fax: (954) 925-1101 Kerry P. Sisselman Reg. No. 37,237





IP SERVICES



Home 1P Services PatentScope Patent Search



Search result: 1 of 1

(WO/2000/004598) SEMI-CONDUCTOR ELEMENT WITH AN EMITTER AREA AND A STOP ZONE IN A PRE-MOUNTED POSITION THERETO

Biblio. Data Description Claims **National Phase Notices**

Publication Number: WO/2000/004598

Latest bibliographic data on file with the International Bureau

International Application No.: PCT/DE1999/002082

Publication Date: 27.01.2000 Chapter 2 Demand Filed: 08.02.2000

International Filing Date:

05.07.1999

Documents

Int Class,;

H01L 29/10 (2006.01), H01L 29/739 (2006.01), H01L 29/745 (2006.01), H01L 29/749 (2006.01)

Applicants:

INFINEON TECHNOLOGIES AG [DE/DE]; St.-Martin-Str. 53 D-81669 München (DE) (All Except US). BAUER, Josef-Georg [DE/DE]; Eglersried 5 D-85229 Markt Indersdorf (DE) (US Only). BRUNNER, Heinrich [AT/DE]; Dammeriberg 59 D-84405 Dorfen (DE) (US Only). SCHULZE, Hans-Joachim [DE/DE]; Ottostrasse 60F D-85521 Ottobrunn (DE) (US Only).

Inventors:

BAUER, Josef-Georg (DE/DE); Eglersried 5 D-85229 Markt Indersdorf (DE). BRUNNER, Heinrich [AT/DE]; Dammer/berg 59 D-84405 Dorfen (DE). SCHULZE, Hans-Joachim [DE/DE]; Ottostrasse 60F D-85521 Ottobrunn (DE).

DOKTER, Eric-Michael; Steinsdorfstr. 6 P.O.Box 221443 D-80538 München (DE). Agent: Priority Data: 198 32 310.7 17.07.1998 DE

Title:

(EN) SEMI-CONDUCTOR ELEMENT WITH AN EMITTER AREA AND A STOP ZONE IN A PRE-

MOUNTED POSITION THERETO

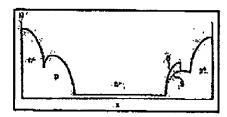
(DE) LEISTUNGSHALBLEITERELEMENT MIT EINEM EMITTERBEREICH, DEM EINE STOPPZONE

VORGELAGERT IST

Abstract:

)

(EN) The invention relates to a semiconductor element with an emitter area (5) and a stop zone (6) arranged in a pre-mounted position thereto, whereby the emitter area (5) and the stop zone (6) have opposing types of conductivity. In order to reduce static and dynamic loss in the power conductor as is currently the case in prior art, the atoms used in the stop zone (6) are foreign atoms that have at least one energy level that is located within the band gap of the semiconductor and arranged at a distance of at least 200 meV from the conduction band and valence band of the semiconductor.



(DE) Die Erfindung betrifft ein Leistungshalbleiterelement mit einem Emitterbereich (5), dem eine Stoppzone (6) vorgelagert ist, wobei die Leitfähigkeiten des Ernitterbereichs (5) und der Stoppzone (6) einander entgegengesetzt sind. Um sowohl die statischen als auch die dynamischen Verluste des Leistungshalbleiters kleiner als beim Stand der Technik zu machen, wird vorgeschlagen, als Fremdatorne in der Stoppzone (6) Atome zu verwenden, die mindestens ein Energieniveau haben, das innerhalb der Bandlücke des Halbleiters liegt und von Leitungs- und Valenzband des Halbleiters mindestens 200 meV entfernt ist.

Designated States:

AE, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU,

European Patent Office (EPO) (AT. BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT,

Publication Language:

Filing Language;

German (DE)

German (DE)

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

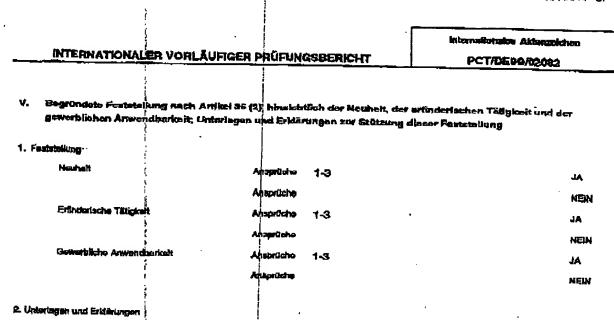
(Adukt 36 und Regal 70 PCT)

		ì	
	Aktustishen des Anmelders vo GR 95P2124P	WEITERES VORGEHEN	siche Minniung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formbiett PCT/IPRA/416)
	PCT/DE 99/ 02082	1 05/07/19	Anneldedatum (Tag/Monel/Jahr) dir) 99 17/07/1998
	Interpoliciale Patenti applicati	on (IPK) odor nationale Kla	rifikulion und IPK
	Armelter	H01129/0	D
	SIKHENS AKTIENGES	LISCHAFT et al.	
	i. Der internationale werl Behörde arstallt und wi	uligo Prüfungsbericht wurd is dem Aumelder gemäß Ar	e Von der mit der internacionalen vorMuliges Prüfeng bezeitungen ülch 36 übermittelt.
•	2. Diese BBRICHT um	fallt insparantS	Biltner einschließlich dieses Deckblatts,
	Außerdem Begen de Zeichetungen, die ge megen Berichtigung	m Bericht ANLAGEN be Indert wurden und diesent 1 en (wiele Regel 70.16 und A	is debel handelt es sich um Bittler mit Boschreibungen. Ansprücken und/oder ericht segraade liegen, und/oder Distier mit von dieser Behörde vorgenose- tsehnist 607 der Verwaltungsvorsehriften zum PCT)
	Diese Antagen umfasser	ingtont Bir	Tet.
	3. Dieser Beneist entiste A	agaban und die enceproches	den Seisen zu folgendes Punkten:
	1 X Grandispe di	:	<u> </u>
:	∏ Priorigg	,	
	Ili 🔲 Keine Erstell	Mg wans Gutschtens Aber	visikai, erlinderische Tätigteit und gewerbliche Anwendharkeit
	IV Mangalasie E	nheithchkeit der Befindung	
. *	Progrativiste F	estaciking nach Articol 350 Amwardbarkoit: Unterlagen	l) bigsichtlich der Neubeit, des erfinderischen Tänigkeit und der und Erklärungen zue Stätenung dieser Franzeitung
	<u> </u>	produm Unterlagen	·
		ingel der internationalen A	
3	. VIII (X) Mentinggate Be	metkungen and jugamation	ica Ameridang
			}
	[,
		i !	1
	Į.	(1
		·	
	Datum der Einreichung des Antra		Datum der Fertigmellung dieser Berichte
	08/02/2000		.1 4. 04. 00
	Name and Postanechellt der mit de Peliting besuttragten Behörde Buroplinehas Patent D-50295 München Tel. (+49-59) 2299. Faz: (+49-59) 2299.), Te: 527694 gmmu d 3465	
1	Formblax PCT/(PEA/409 (Decktha	(Juli 1998)	(10/4/2030)
		<u> </u>	
		1	
	05. DEZ.	2000 (DI) 16:26	VERBINDUNG Nr. 4 8. 3

	İNTE	RNATIONAL	En vorläufiger f	RÜFUNGSBERICHT	Internationales Aktenzelci PCT/DE09/02082
i. (irind!	ige des Berli	Sila		
1. Dies	er Batk 1901, gw	Stri warde erstell Flettille vil tief	t juli daş Grundağa (Grede) Clemen Wellchis vilv Viraprus	i lattur, tile dem Animeldeent auf eim 1984) of gerofah? und aind inm nich	a Autordorung mach Aftikal 14 hin vo t belgetigt, wall die insine Anderunge
	B	det interneto	naion Anmeidung in der un	entrelich eingereichten Fassung	
	0	der Beechreit	oung, Selle	in d	er ursprünglich singereichben Fessun
		į	Collo	, ude r	egerelisht mit dem Ankreg
		!	Seite	, == 1	gereicht mit Schreiten vom
		der Ansprüch	e, Nr.	i In de	er umprünglich eingereichem Passan
,		!	Nr.	ir; et	er nach Arlikei 18 geendormin Fessun
			Nr.		gereicht mit dem Antreg
		}	Nr.	, ein	garelati mit Schnilben vom
		der 2016hmun	gan, Eliatt / Abb,	în de	or unaprimiglich eingereichten Passung
		į	Bien / Abb.	, obr	garaloht mit dam Antrag
		;	Bi≄tt / Abb.	, ein	gereicht mit Schreibett vorn
오 시네넷	und der	Anderungen al	nd falgende Unterlegen for	mefallén:	
	<u> </u>	Beschreibung			
	0	Ansprüche:	Nr.		
		Z#6hnungen;	(Biett / Anb.		•
э, 🛅	ange	er Bericht ist of Igebonen Gründ Pegehen (Regel	ion nach Auffabliche der Di	ingen) der ånde Ungen ersleit sen shörde über den Offenbarungsgehali	årn, da diese mus den im Zusacziejd tin der weprünglich eingereichten Pe
4. Ebraij	go Izveš	; tzliche Bemericu	ngen:	-	
		. !			
		į			
		İ			
Formation PC/C	A PF: mades	i i least-superij (i tiefij) i	O Blue		•
				•	

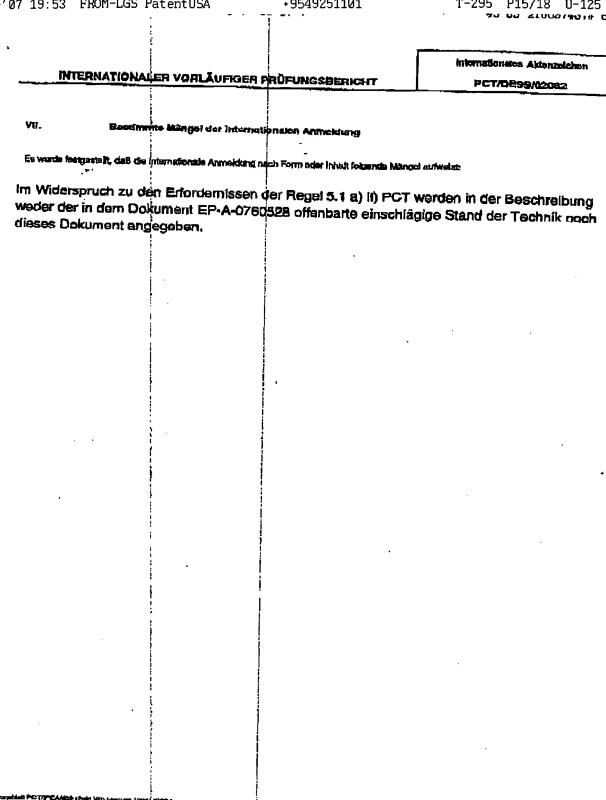
05. DEZ. 2000 (DI) 16:26 _ VERBINDUNG Nr. 4

3



Druckschrift EP-A-0760528 beschroibt ein Halbleiterbauelement mit hochsperrendem Randabschluß, wobei der Randabschluß mit einem Dötierstoff verunreinigt ist, der ein tiefes Störstellen-Energieniveau von wenigstens 100 meV (z. ß. Selen oder Schwefel) aufweist. Bei hohen Sperrspannungen werden die Detierstoffatome im Randabschluß trotz ihrer tiefen Störstellenniveaus weitgehend lonisient und erzeugen eine Raumladung.

Die Erfindung nutzt diese bekannte "Fellsebhängige lonisierung", um den Durchgriff des elektrischen Feldes auf den Ernitter bei voller Sperrspannung zu verhindern. Der Gegenstand des Anspruchs 1 und der abhängigen Ansprüche 2 und 3 wird nicht durch den bekannten Stand der Technik nahegelegt.



VERBINDUNG Nr. 4

05. DE2. 2000 (DI) 16:27

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PROFUNGSBERICHT PCT/DE99/02082 VIII. Bestberete Benerkungen zur internationalen Anmekung Zur Klarhalt der Patentensprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vossen Limitang durch die Die Definition des Gegenstands des Anspruchs 1 sollte durch die Angebe der Funktion der Stoppzone erganzt werden (siehe Seite 1, Z. 15-17) (Artikel 6 PCT).

j

05. DEZ. 200,0 (D1) 16:27

VERBINDUNG Nr. 4

140 }

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

An	ng beauftrag		7	PCT
SIEMENS ÁRT Postisol 22 D-80506 Min ALLEMAGNE		MAFT .	PES INTER	ng über die Obersendung Inationalen vorlaufigen Rofungsberichts
	;			(Regel 71.1 PCF)
			Alsemelectricum (Tittel Mona (Lister)	1 4, 04, 00
Aktenzektren der Ann GR 98P212		tr	Wich	TIGE MUTTERLUNG
PCT/ DR 99		(Tre/Mongilish) 05/07/199	Makinπ 99	Prioristatum (Tig/Monat/Jahr) 17/07/1998
Untackder				27/07/2208
STEMENS A	KTYENGRERY.T.	CHAPT at al.		·
Deca Assembler w internationalen Ar übermittelt.	erd criticatells, daß ; nmcidung er stellen	in die mit der internati Internationalen vorfäufi	onaica vorläufigen Profiu gen Prifiungsberjeht, gage	g besufingte Behinde hierrijk den zu der beufalb mit den dasugehörigen Anlagen,
Eine Kopie des Bu Sugtwählten Am	white wird grant	enfalls mit den davlerste		
•	en gentikering		Frigan Arthysis - dods late	thegrifiaget 2010 an Acideticine at elle
Auf Wonson eines	toernatives.	to with the Entered from the		-
Auf Worsch eine Begüsche entbeig	I allayewithten Am	to with the Entered from the		-
Auf Worsch einer Englische enferig ERINNERUNG	Falispewinden Am	r whil des International Aberminett.	e Büro sins Obersetzung (des Berichts (jodoch nicht der Anlegen) ins
Auf Women cines Englische enterig ERINNERUNG Dien Eintrich in die datum (oder in ma Gobilines) vorzum Informacion). Ist charm massrwii.	Fallingewithlien Amiles und dissign Amiles Amiles Passes in antionale Passes in antionale (Artirel 39)	at dier Ammebier vor jed h später) bestiemen Mar (1)) (siehe uuch die durch erzetzung der Internation	e Büre eine Übersetzung o om ausgewählen Amt inn pilungen (Einreichung vor h das liebernstiennie Bijro	des Berichts (jodoch nicht der Anlegen) ins erhalb von 30 Messten ab dem Prinritus- nit Formblett PCT/(B/30) übermitzig mit Formblett PCT/(B/30) übermitzig
Auf Women cines Englische enterig ERINNERUNG Dien Eintrich in die datum (oder in ma Gobilines) vorzum Informacion). Ist charm massrwii.	rationale Phase in the American American American American Phase in the American Phase in the American Puri international Phase in the American Puri international Phase in the American Puri international Phase in the American Puri den	at der Ammetter ver jed h später) bestimmer Har (1)) (siehe each die durc emation alen vorfähligen betroffensa Ausgewähle	e Büro eine Übersetzung o ora ataşırwikiben Aust inn pilungen (Einreichting vor h that linkernationale Büro- ralos Arasteldung ku über Prüfungsbericht enthalte is Austern direkt zuzulehe	des Berichts (jodoch nicht der Anlagen) ins erhalb von 30 Musaten ab dem Primitüra- n Übersetzungen und Entrichtung radenak mit Formhlatt PCT/f8/301 übermitzige mit Formhlatt PCT/f8/301 übermitzige mitzahn, an muß diese Übersetzung auch a. Er ist Aufgabe des Anmeiders, rolche
ERINNERUNG ERINNERUNG Zian Empiric in dictatum (odar in ma Goldinas) waxam information). Let cheen magewill Universitatingen also Obstructungen aus Weiters Einzelbeite.	rationale Phase in the American American American American Phase in the American Phase in the American Puri international Phase in the American Puri international Phase in the American Puri international Phase in the American Puri den	at der Ammetter ver jed h später) bestimmer Har (1)) (siehe each die durc emation alen vorfähligen betroffensa Ausgewähle	e Büro eine Übersetzung o ora ataşırwikiben Aust inn pilungen (Einreichting vor h that linkernationale Büro- ralos Arasteldung ku über Prüfungsbericht enthalte is Austern direkt zuzulehe	des Berichts (jodoch nicht der Anlagen) ins erhalb von 30 Musaten ab dem Primitüra- n Übersetzungen und Entrichtung radenak mit Formhlatt PCT/f8/301 übermitzige mit Formhlatt PCT/f8/301 übermitzige mitzahn, an muß diese Übersetzung auch a. Er ist Aufgabe des Anmeiders, rolche
Auf Worsch einer Englische enfertig Englische enfertig Englische enfertig Englische enfertig Englische enfertigen in die datum (oder in mit Gobellere) vorzum information). Lyt chern mitterviä illervetungen alle Voorschungen met Voorschungen met Englische Anmelder zu entre en	I alisgewählten Am in und dieren Am in und dieren Am in und dieren Am in neden Am inter Amer sine Üter Am inter Amer sine Üter Am inter Amer sine Üter Am inter Amer sine Üter Am inter am inter inter inter inter am auf den nternationen	at der Ammetter ver jed h später) bestimmer Har (1)) (siehe each die durc emation alen vorfähligen betroffensa Ausgewähle	e Büro eine Übersetzung o ora ataşırwikiben Aust inn pilungen (Einreichting vor h that linkernationale Büro- ralos Arasteldung ku über Prüfungsbericht enthalte is Austern direkt zuzulehe	des Berichts (jodoch nicht der Anlagen) ins erhalb von 30 Musaten ab dem Prioritüra- n Übersetzungen und Entrichtung radeenal mit Formhalt PCT/IR/301 übermitselte mitanin, an muß riese Übersetzung auch a. Br ist Aufgabe des Annachten, solche n. Amter sind Bund II des PCT/Leitfadens
PRIMINERUNG Diss Englische enferig PRIMINERUNG Diss Englische enferig Diss Elegische enferig Gestlings) vorzup information). Int charm massevel Untrectungen alle Occurrences Welters Eingelheits Annelder zu entre Ochon besonfragten B Europäin Tal. (+ 44	e nationale Passe in antionale P	at die Ammetter vor jed h später) bestimmer Har (1)) (siehe each die dura erantzung der Internation erantzung der Internat	e Büro eine Übersetzung o om ausgewählten Aust inn pilungen (Einreichtung von das kohernationale Buro- talos Austeldung zu über- Prüfungsbericht enthalten in Austern direkt zuzulehe dernässen der ausgewählten	Asmter sind Bund II des PCT-Leitfedens :

05. DEZ, :2000 (DI) 16:26

÷ ;

VERBINDUNG Nr. 4

8. . 2

i

Der Autrag ist bei der zuständigen mit der intermationalen vorlaufigen Präfung basuftragten Behörda oder, wenn zwei oder mehr Behörden zuständig sind, bei der vom Anmelder grundlich Behörde einzweichen. Der Anmelder kann den Namen oder den Zweibuchstaben-Code der Behörde auf der nochstehendem Zeile angeban.

IPEA/ EP

PCT

KAPITEL II

ANTRAG AUF INTERNATIONALE VORLÄUFIGE PRÜFUNG

nach Artikel 31 des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens:

Der (die) Unterzeichmete(n) beautragen), daß für die nachstehend bezeichmete internationale Anmeldung die internationale vorläufige Pröfing nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens durchgeführt wird und beneumt biermit als ausgewählte Staaten (soweit nichts anderes angegeben).

Von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde auszufüllen Eingangsdatum des ANTRAGS Bezeichnung der IPEA Aktenzeichen des Ammelders oder Anwalts KENNZEICHNUNG DER INTERNATIONALEN ANMELDUNG (Prohester) Prioritätstag (Tophioralkir) Internationales Annualdedatum (Togi Acat Litt) Internationales Aktenzeichen 17/07/1898 PCT/DE 99/02082 05/07/1999 **a** Leistungshalbleitereiement mit einem Emitterbereich, dem eine Stopzone vorgelagert ist Feld Nr. II ANMELDER Name und Anschrift (Fundiorisms Norvans bei printerin Personation des State onweiter Bessi I verg. Bei der Anschrift wird die Positisch in wie der Norm der State onweiten) Telefonnr.: (089) 636-8 28 19 Telefæore: Siemens Aktiengesellschaft (089) 636-8 18 57 Wittelsbacherplatz 2 Fernschreibnr.: D-80333 München DE 52100-0 sie d Sitz oder Wolmsitz (Street): Staatsangehörigkeit (Staat): DE Name und Anschrift: (Fondernie Vorune; es promier Former volstiedige ordine Besthrung. Dei de Anchrif siel die Posteigebund der Norm der Socte erzogebor) BAUER, Josef-Georg Eglersried 5 D-85229 Markt Indersdorf Sitz oder Wohnsitz (Staat): Steatsangehörigkeit (Staat): DE Nama und Anschrift: (Familiareins, Vernous, ba pasareins Paramenellett eligenstiche Beseichung, Baiter Anschrift und die Positionille der Nors der Steets ansgebeit BRUNNER, Heinrich Dammeriberg 59 · D-84405 Dorfen DE Sitz oder Wohnsitz (Steat): Staatsangehörigkeit (Staat): AT Weitere Anmelder sind auf einem Fortsetzungsblatt angegeben.

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.